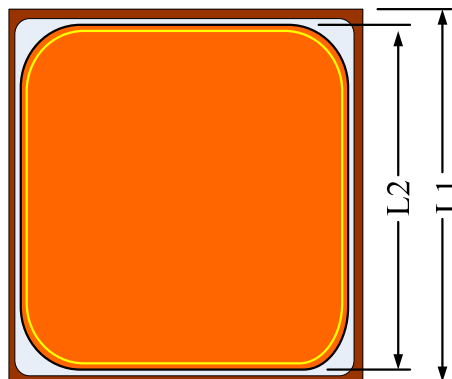


1N5817-28/1N5819-28/SR160-28 肖特基二极管芯片

简述:

- ✚ 本肖特基二极管芯片采用硅外延工艺制造;
- ✚ 损耗功率小, 效率高;
- ✚ 采用瞬态反应能力的保护环结构;
- ✚ 具有较高 ESD 抗静电击穿能力;
- ✚ 具有高抗浪涌电流能力;
- ✚ 可广泛应用于开关电源、整流电路及极性保护电路等各类电子电路中;
- ✚ 芯片图形尺寸: $710 \times 710 \mu\text{m}$;
- ✚ 芯片厚度: $280 \pm 10 \mu\text{m}$;
- ✚ 可分别适用于轴向封装及金丝和硅铝丝压焊封装。



芯片尺寸示意图

 芯片尺寸 L1: $710 \mu\text{m}$;

 压点尺寸 L2: $690 \mu\text{m}$;

极限参数:

参数名称	符号	额定值			单位
		1N5817-28	1N5819-28	SR160-28	
最大直流阻断电压	V_{RRM}	20	40	60	Volts
正向平均整流电流	I_{FAV}	1			Amp
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I_{FSM}	30			Amps
最高工作结温	T_J	125			$^{\circ}\text{C}$
芯片存储温度	T_{STG}	-40~+125			$^{\circ}\text{C}$
最低抗静电电压	ESD	8000			Volts

电参数及规格 ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$):

参数名称	符号	测试条件	额定值			单位
			1N5817-28	1N5819-28	SR160-28	
反向击穿电压	V_{BR}	$I_R=100 \mu\text{A}$	≥ 25	≥ 45	≥ 65	Volts
正向压降	V_F	$I_F=1\text{A}$	≤ 0.43	≤ 0.53	≤ 0.63	Volts
反向漏电流	I_R		$I_R \leq 30 @ V_R=25\text{V}$	$I_R \leq 30 @ V_R=45\text{V}$	$I_R \leq 30 @ V_R=65\text{V}$	μAmps
特性曲线 $\Delta V_R \leq$	ΔV_R	$I_{R1}=50 \mu\text{A}$ $I_{R2}=500 \mu\text{A}$	≤ 4			Volts